## ⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-147063

51 Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月8日

C 23 C 14/36

8520 - 4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称 マグネトロン・スパツタ装置

> 21)特 願 昭62-306143

22出 願 昭62(1987)12月3日

中村 ②発 明 者

久 三

千葉県印旛郡八街町八街ほ672-20

⑫発 明 者 太田 賀 文

千葉県印旛郡八街町八街に-129

⑫発 明 者 樋  靖

千葉県印旛郡八街町朝日617-2 梅ノ里寮

⑫発 明 者

石 橋 暁

茨城県竜ケ崎市上大徳新町45

①出 願 人 日本真空技術株式会社

神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地

個代 理 人 弁理士 飯阪 泰雄

> 明 細

1 発明の名称

マグネトロン・スパッタ装置

- 2 特許請求の範囲
  - とを備えたマグネトロン・スパッタ装置におい て、前記磁界発生装置と前記ターゲットとの間 に板状の磁性部材を介設し、その前配磁界発生 装置の磁極間に対向する部位に複数の空隙又は 磁気抵抗の特に大きい部分を形成させるように したことを特徴とするマグネトロン・スパッタ 装置。
  - (2) 前記ターゲットの支持板に前記磁性部材を 取付けた前記第1項に記載のマグネトロン・ス パッタ装置。
- 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は基板に薄膜を形成するのに用いられる マグネトロン・スパッタ装置に関する。

[ 従来の技術及びその問題点]

マグネトロン・スパッタ装置は、基板にターゲ ットの材料を効率よく、その薄膜を形成させるの に用いられるものであるが、第7図はこの-従来 例を示し、磁性材で成るョーク(1)上に磁極(2ª)(2b) (1) 磁界発生装置とこれに近接してターゲット 及び中心磁極(3)が形成されている。本例では、こ れらは永久磁石から成るもので、断面は山形を呈 しているが、実際には中心磁極(3)と同心的に外側 磁極 (2a)(2b) が形成されている。すなわち (2a)と (2b)は一体的となっている。中心磁極(3)は上方が N極、下方が S極であり、この外方の磁極 (2z)(2b) は上方がB極、下方がN極となっている。従って、 中心の磁極(3)から矢印Hで示すよりに、磁力線H が外側磁極(21)(26)に流入するようになっている。 なお本例では、永久磁石で磁界発生装置を構成す る場合を説明したが、これは電磁石で構成しても よい。この場合には中心磁極N-8の周囲にコイ ルが巻装されることになる。磁極 (2a)(2b) (3)に近 接して、ターゲット支持板似が配設され、とれに ターゲット(5)が支持されている。磁力線片は磁極 (21)と(3)、又は(3)と(21)との間で、その方向がタ

ーゲット(5)の面に対しほゞ平行になるために、この部分において、ブラズマが集中するようになっている。従って、このターゲットからイオンが飛び出すのは、ハッチングで示した部分に5m)がきれる(エロージェン)。そして、その他の部へにおいては、ハッチングで示されてないように、ほとんど侵食されることは言えない。すなわちその利用効率は非常に低いものである。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は以上の問題に鑑みてなされ、ターゲットの使用効率の大きいマグネトロン・スパッタ装置を提供することを目的とする。

[作用]

複数の空隙又は磁気抵抗の特に大きい部分に対向する位置で平行磁界の強度が最大となる。このような空隙又は磁気抵抗の特に大きい部分が複数、設けられることにより平行磁界の強い部分が広がり、よってターゲットのエロージョンは従来より

は、同心状に形成され、中心部(111)、これと同 心的な中間部(116)及びこれと同心的な外周部 (11c)から成っており、これらの間に間隙(12≥) (12b)を形成させている。本発明の第1実施例は 以上のように構成されるのであるが、次にこの作 用について説明する。永久磁石の磁極切からは第 1 図の矢印で示すように、磁力線 H'が流出し、大 部分は中間磁性板部(116)へと流入し、これから 外方の磁極部 (2a)(2b) へと外周部 (11c) を介して 流入する。そして部分的に磁極(3)から外方の磁極 (2a)(2b)へ流れる。すなわち、従来は殆んど全て の磁力線が中央の磁極(3)から、直接、外方の磁極 (2a)(2b)へ流れていったのであるが、本実施例に よれば、図で示すような磁力線のいわば短絡路が 形成される。従ってこのような磁力線について、 その垂直成分と平行成分についてグラフで示せば、 第3図のようになる。この図から明らかなように 垂直成分は、ターゲット(5)の両端部において最大 値を示し、これから内方に向うにつれて急激に減 少し、空隙 (121)(12b) に対応する部分でほとんど

一段と均一化される。すなわち、ターゲットの利 用効率を向上させることができる。

#### 〔寒施例〕

以下、本発明の実施例によるマグネトロン・スパッタ装置について、第1図乃至第6図を参照して説明する。

第1図乃至第3図は本発明の第1実施例を示す ものであるが、第7図の従来例に対応する部分に ついては同一の符号を付し、その詳細な説明は省 略する。

すなわち本実施例の磁界発生装置は永久磁石で構成され、その形状は同心円状である。そして、この永久磁石の磁極 (2a)(2b) (3) にわずかな空隙をおいて、ターゲット支持板 (4) (いわゆるバッキングブレート) が配設される。これは従来例と同様に、磁性材ではない他の金属であり例えば、銅で成るものである。そしてこの上にターゲット(5) が支持な (4) に第 2 図に示すようを形状の磁性板(1) で建設されている。すなわち、本実施例の磁性板(1)

本実施例によれば以上のような磁界分布を示すので、第1図に示すようなエロージョン (13a)(13b)が形成され、ターゲット(5)は一様に侵食されることになることにより、その利用効率は従来と比べるとはるかに高いものである。

以上の実施例で、例えば磁性板(II)の厚みを 3 m/m とし、これをパーマロイで形成し、間隙 (12 a)(12 b) 幅を 10 m/m とし、またターゲット(5)の径を 6 インチ ø、 その厚みを 6 mm でクロム (Cr) で成るものとすれば、ターゲット(5)の使用効率は 55 % であったが、同じ材料、かつ同じサイズで従来例ではその使用効率は 25 % であった。

増大させるようにしてもよい。

また、以上の実施例では磁性板の材料としてパーマロイが用いられたが、他の磁性材であっても よいが透磁率の高い材質で好ましい。

また、以上の実施例では磁界発生装置としては

第6図は本発明の第3実施例を示すものであるが、第1実施例に対応する部分については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。

本実施例によれば、ターゲット支持板500には第 1 実施例と同様に磁性板511が埋設されており、またれば第1実施例と同様に同心的な形状を有するものであるが、その中心部522と外周部533との厚みより大きくしてもののは気があるものとしている。このはすれば、磁極(3)から(21)(2b)に向う磁気ができる。とは、磁速ではなって強速をより強くすることができる。上記実施例で述べた効果を奏するものである。

以上本発明の各実施例について説明したが、もちろん本発明はこれらに限定されることなく、本発明の技術的思想に基ずいて種々の変形が可能である。

例えば、以上の実施例では磁性板(I) 20 (30) には 2 つの空隙が形成されたがさらにこれを増加するようにしてもよい。 するわち、以上の実施例では磁性板は、分割構造としたが、この分割数をさらに

永久磁石を用いたが、冒頭で述べたように電磁石であってもよい。またその磁石の形状も同心的なものでなく、断面形状が同じくE型であっても中心磁極の両側に対応する磁極が相独立した磁極であっても同様な効果が得られることはもちろんである。

#### [発明の効果]

以上述べたように本発明のマグネトロン・スパッタ装置によれば、従来に比ベターゲットの利用 効率を一段と向上させることができ、よって生産コストを低下させることができる。また、ターゲットの交換のインターバルを従来より長くすることができる。

#### 4 図面の簡単な説明

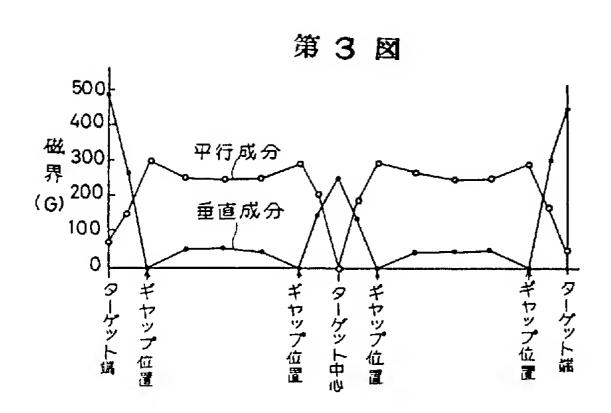
第1図は本発明の第1実施例によるマグネトロン・スパッタ装置の部分断面側面図、第2図は第1図における磁性板の平面図、第3図は同実施例の作用を説明するためのグラフ、第4図は同実施例の作用と比較するための従来例の作用を示すグラフ、第5図は本発明の第2実施例のマグネトロ

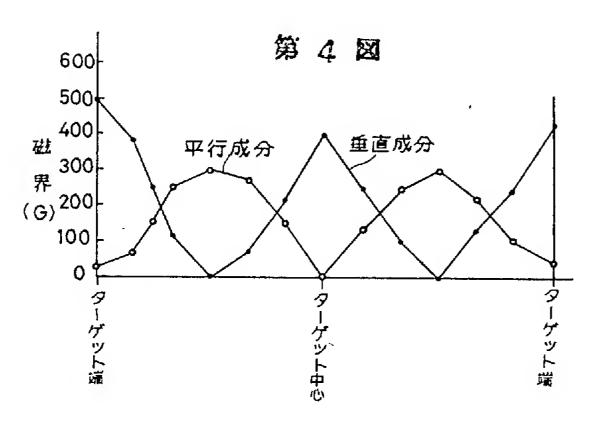
ン・スパッタ装置に用いられる磁性板の平面図、 第6図は本発明の第3実施例によるマグネトロン・スパッタ装置の部分断面側面図、及び第7図は 従来例のマグネトロン・スパッタ装置の部分断面 側面図である。

なお図にむいて、

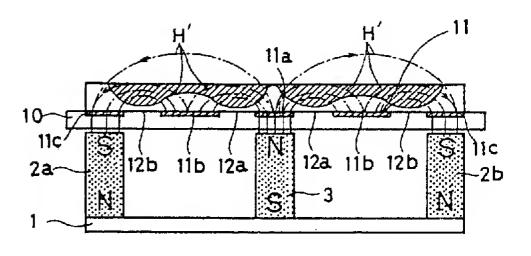
(11) 20(31) ...... 磁 性 材

代 理 人 飯 阪 泰 雄

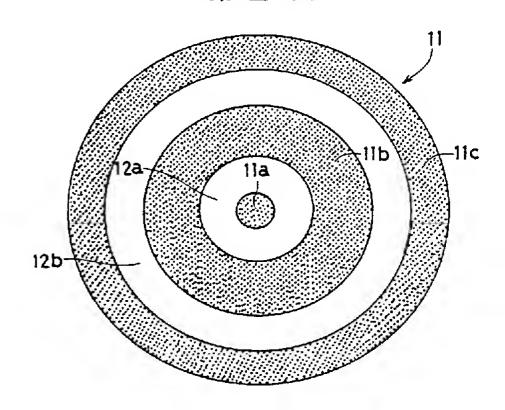




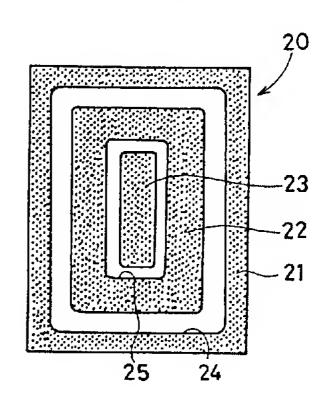
## 第 1 図

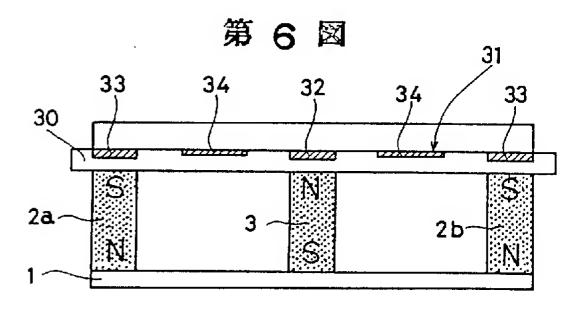


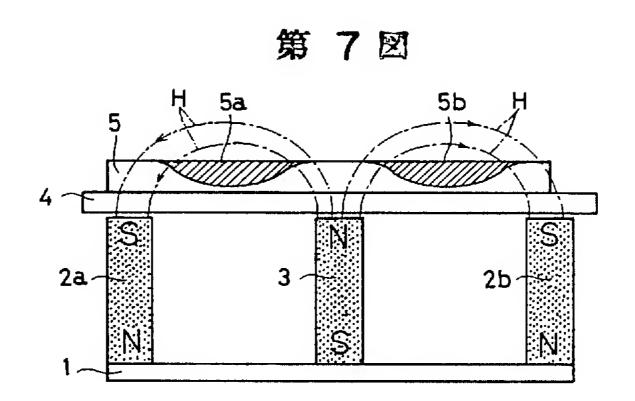
第 2 図



第5図







**PAT-NO:** JP401147063A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 01147063 A

TITLE: MAGNETRON SPUTTERING DEVICE

PUBN-DATE: June 8, 1989

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NAKAMURA, KYUZO

OTA, YOSHIFUMI

HIGUCHI, YASUSHI

ISHIBASHI, AKIRA

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

ULVAC CORP N/A

**APPL-NO:** JP62306143

APPL-DATE: December 3, 1987

**INT-CL (IPC):** C23C014/36

US-CL-CURRENT: 204/298.19

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the utilization efficiency of a target by providing a plate-like magnetic member between a magnetic field generator and a target and forming plural voids or parts having high magnetic resistance in the magnetic field

generator.

CONSTITUTION: A target-supporting plate 10 is provided while leaving voids among magnetic poles 2a, 2b, 3 of a magnetic field generator consisting of permanent magnets. Magnetic sheets 11 are buried in the target-supporting plate 10. The magnetic sheets 11 are constituted of concentrically formed central part 11a, intermediate parts 11b, and outside peripheral parts 11c, and spaces 12a, 12b are formed among the above. The lines H' of magnetic force flown out of the magnetic pole 3 are allowed to flow mostly into the intermediate magnetic sheet part 11a and then flown via the outside peripheral parts 11c into the outward magnetic poles 2a, 2b, and, they are partially allowed to flow from the magnetic pole 3 to the outward magnetic poles 2a, 2b. By this method, a target can be uniformly eroded and the utilization efficiency of the target can be improved.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio